

# 上海伯东代理美国原装进口 KRI 霍尔离子源 eH 2000

产品名称	上海伯东代理美国原装进口 KRI 霍尔离子源 eH 2000
公司名称	伯东企业(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:KRI 型号:eH 2000 名称:霍尔离子源
公司地址	ec@hakuto-vacuum.cn
联系电话	021-50463511 13918837267

## 产品详情

KRI [霍尔离子源 eH 2000](#)上海伯东代理美国原装进口 KRI [霍尔离子源 eH 2000](#) 是一款更强大的版本, 带有水冷方式, 他具备 eH 1000 所有的性能, 低成本设计提供高离子电流, 特别适合大中型真空系统. 通常应用于离子辅助镀膜, 预清洗和低能量离子蚀刻. 尺寸: 直径= 5.7 " 高= 5.5 " 放电电压 / 电流: 50-300V / 10A 或 15A 操作气体: Ar, Xe, Kr, O2, N2, 有机前体 KRI [霍尔离子源 eH 2000](#) 特性 水冷 - 与 eh 1000 对比, 提供更高的离子输出电流 可拆卸阳极组件 - 易于维护; 维护时, \*大限度地减少停机时间; 即插即用备用阳极 宽波束高放电电流 - 高电流密度; 均匀的蚀刻率; 刻蚀效率高; 高离子辅助镀膜 IAD 效率 多用途 - 适用于 Load lock / 超高真空系统; 安装方便 等离子转换和稳定的功率控制 KRI [霍尔离子源 eH 2000](#) 技术参数

型号	eH 2000 / eH 2000L / eH 2000x02/ eH 2000 LEHO
供电	DC magnetic confinement
- 电压	40-300V VDC
- 离子源直径	~ 5 cm
- 阳极结构	模块化
电源控制	eHx-30010A
配置	-
- 阴极中和器	Filament, Sidewinder Filament or Hollow Cathode
- 离子束发散角度	> 45 ° (hwhm)
- 阳极	标准或 Grooved
- 水冷	前板水冷
- 底座	移动或快接法兰
- 高度	4.0'
- 直径	5.7'
- 加工材料	金属电介质半导体
- 工艺气体	Ar, Xe, Kr, O2, N2, Organic Precursors

- 安装距离 16-45 ”
- 自动控制 控制4种气体

\* 可选: 可调角度的支架; SidewinderKRI [霍尔离子源](#) eH2000 应用领域 离子辅助镀膜  
IAD 预清洗 Load lock preclean 预清洗 In-situ preclean Direct Deposition Surface  
Modification Low-energy etching III-V Semiconductors Polymer Substrates

1978 年 Dr. Kaufman 博士在美国创立 Kaufman & Robinson, Inc 公司,  
研发生产[考夫曼离子源](#), [霍尔离子源](#)和[射频离子源](#). 美国[考夫曼离子源](#)历经 40  
年改良及发展已取得多项专利. 离子源广泛用于离子清洗 PC, 离子蚀刻 IBE, 辅助镀膜 IBAD, 离子溅射镀膜  
IBSD 领域, 上海伯东是美国[考夫曼离子源](#)中国总代理.

若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请参考以下联络方式:

上海伯东: 罗女士